



## Toshiba führt 100V n-Kanal Leistungs-MOSFETs für industrielle Anwendungen ein

*Zusätzliche U-MOS IX-H Bausteine bieten niedrigsten Durchlasswiderstand ihrer Klasse*

**Düsseldorf, Deutschland, 07. Februar 2018** – Toshiba Electronics Europe hat mit dem Versand von zwei neuen 100 V Bausteinen seiner Niederspannungsserie von U-MOS IX-H n-Kanal Leistungs-MOSFETs begonnen. Die neuen Bausteine sind ideal geeignet für Stromversorgungsanwendungen in industriellen Geräten sowie Motorsteuerungen.

Sie werden mit dem neuesten Niederspannungs-Trench-Prozess (U-MOS IX-H) von Toshiba hergestellt. Die MOSFETs TPH3R70APL und TPN1200APL bieten den niedrigsten Durchlasswiderstand von 3,7 m $\Omega$  bzw. 11,5 m $\Omega$  ihrer Klasse. Die Bausteine verfügen über eine niedrige Ausgangsladung ( $Q_{OSS}$ : 74 / 24 nC) sowie eine niedrige Gate-Schaltladung ( $Q_{SW}$ : 21 / 7,5 nC) und sind für eine 4,5V Logic-Level-Ansteuerung geeignet.

Im Vergleich zu aktuellen Bausteinen, die mit dem U-MOS VIII-H Prozess hergestellt werden, verfügen die neuen Bausteine über bessere Leistungszahlen für MOSFETs für Schaltanwendungen, darunter  $R_{DS(ON)} \cdot Q_{OSS}$  und  $R_{DS(ON)} \cdot Q_{SW}$ .

Der TPH3R70APL ist in einem 5 mm x 6 mm SOP-Advance Gehäuse untergebracht und kann Drain-Ströme ( $I_D$ ) bis zu 90 A bewältigen, während der TPN1200APL in einem 3 mm x 3 mm TSON-Advance Gehäuse untergebracht ist und  $I_D$ -Niveaus bis zu 40 A schaltet.

Toshiba Electronics Europe wird sein MOSFET-Portfolio gemäß Markttrends weiterentwickeln, um die Effizienz von Stromversorgungen zu verbessern.

###

**Über Toshiba Electronics Europe**

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) ist die europäische Niederlassung der [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#). TEE bietet europäischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl an Hard Disk Drives (HDD) sowie Halbleiter Lösungen für Automotive, Industrie IoT, Motor Control, Telekommunikation und Netzwerktechnik oder für Endverbraucher- und Haushaltsgeräte-Applikationen. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst integrierte Wireless ICs, Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, optische Halbleiter, ASICs, ASSPs und diskrete Komponenten, von Dioden bis hin zu Logic-ICs.

TEE wurde 1973 in Neuss, Deutschland gegründet, mit heutigem Hauptsitz in Düsseldorf. Von dort aus sowie weiteren Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien werden Design, Fertigung, Marketing sowie Verkauf gesteuert. Präsident des Unternehmens ist Mr. Akira Morinaga. Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com).

**Ansprechpartner für Veröffentlichungen:**

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)

E-mail: [discrete-ic@toshiba-components.com](mailto:discrete-ic@toshiba-components.com)

**Ansprechpartner für die Presse:**

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

**Herausgegeben durch:**

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

E-mail: [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)

Februar 2018

Ref. 7115/A